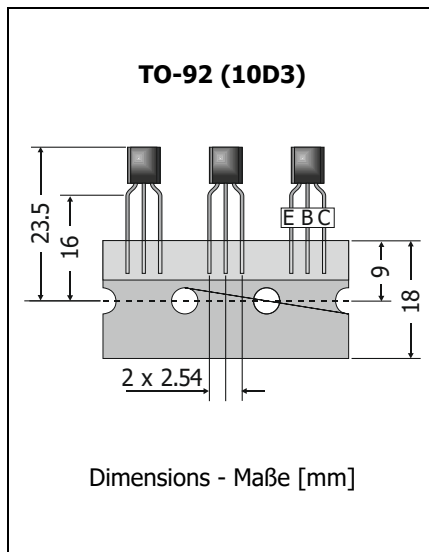


2N2907A
General Purpose PNP Transistors
Universal-PNP-Transistoren

$I_C = -600 \text{ mA}$
 $h_{FE} \sim 200$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = -60 \text{ V}$
 $P_{tot} = 625 \text{ mW}$

Version 2017-12-07

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

General Purpose
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

(1) Taped in ammo pack
 (Raster 2.54)

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions



4000

0.18 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Universell anwendbar
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

(1) Gegurtet in Ammo-Pack
 (Raster 2.54)

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Recommended complementary NPN transistors
Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren

2N2222A

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			2N2907A
Collector-Emitter-volt. - Kollektor-Emitter-Spannung	E open	- V_{CBO}	60 V
Collector-Emitter-volt. - Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CE0}	60 V
Emitter-Base-voltage - Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	5 V
Power dissipation - Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ³⁾
Collector current - Kollektorstrom	DC	- I_C	600 mA
Peak Base current - Basis-Spitzenstrom		- I_B	100 mA
Junction temperature - Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C
Storage temperature - Lagerungstemperatur		T_s	-55...+150°C

Characteristics**Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current - Kollektor-Basis-Reststrom					
- $V_{CB} = 50 \text{ V}$	- I_{CBO}		-	-	10 nA
Collector saturation voltage - Kollektor-Sättigungsspannung					
- $I_C = 150 \text{ mA}$, - $I_B = 15 \text{ mA}$ ⁴⁾	- V_{CEsat}		-	-	0.4 V
- $I_C = 500 \text{ mA}$, - $I_B = 50 \text{ mA}$ ⁴⁾			-	-	1.6 V

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified - $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben

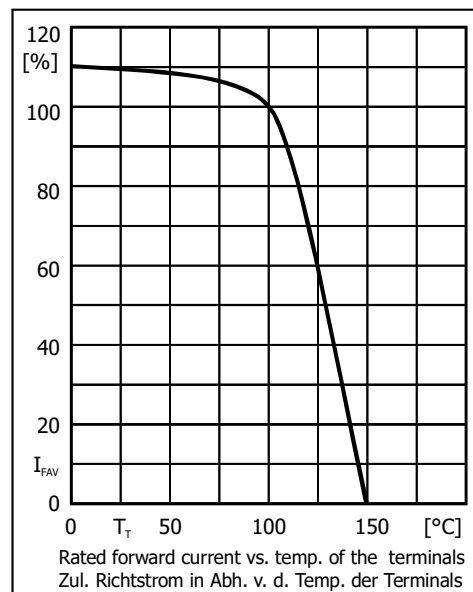
3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

4 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ - Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

		Min.	Typ.	Max.
Base saturation-voltage – Basis-Sättigungsspannung				
- I _C = 150 mA, - I _B = 15 mA ²⁾	- V _{BEsat}	0.6 V	–	1.3 V
- I _C = 500 mA, - I _B = 50 mA ²⁾		–	–	2.6 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis				
- I _C = 0.1 mA, - V _{CE} = 10 V	h _{FE}	75	–	–
- I _C = 1 mA, - V _{CE} = 10 V		100	–	–
- I _C = 10 mA, - V _{CE} = 10 V		100	–	–
- I _C = 150 mA, - V _{CE} = 10 V ¹⁾		100	–	300
- I _C = 500 mA, - V _{CE} = 10 V ¹⁾		50	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- I _C = 20 mA, - V _{CE} = 20 V, f = 100 MHz	f _T	250 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- V _{CB} = 10 V, I _E = i _e = 0, f = 1 MHz	C _{CB0}	–	–	8 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität				
- V _{EB} = 0.5 V, I _C = i _c = 0, f = 1 MHz	C _{EB0}	–	–	30 pF
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebung	R _{thA}	< 200 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%
- 2 Valid if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden